

# METHOD AND SYSTEM FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE

**Publication number:** JP2002041126

**Publication date:** 2002-02-08

**Inventor:** INENAMI RYOICHI; UMAGOE TOSHIYUKI; OKUMURA KATSUYA

**Applicant:** TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

**Classification:**

- International: H01J37/302; H01J37/30; (IPC1-7): G05B19/418; G03F7/20; G06F17/60; H01L21/027

- European: H01J37/302B2

**Application number:** JP20000227324 20000727

**Priority number(s):** JP20000227324 20000727

**Also published as:**

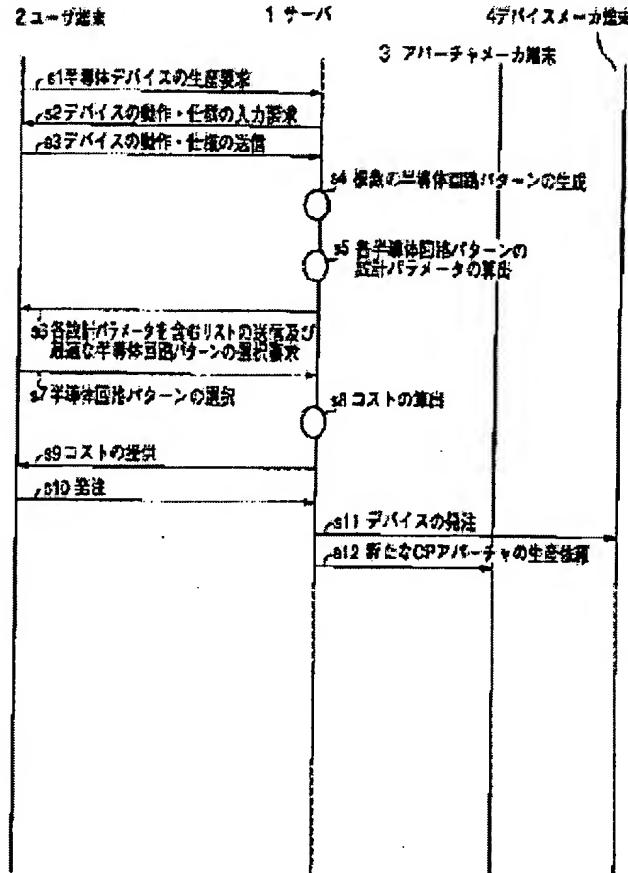
US 7079994 (B2)

US 2002013930 (A1)

[Report a data error here](#)

## Abstract of JP2002041126

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To efficiently produce a semiconductor device fulfilling the needs of a user. **SOLUTION:** A server requests (s2) a user to input the specification of a semiconductor device in response to a request (s1) from the user, and generates (s4) plural circuit pattern based on a CP system based on the specification (S3) provided from the user, and calculates (s5) design parameters for those respective circuit patterns, and provides the information of the plural circuit patterns and the design parameters to the user, and the user is urged to select the circuit pattern (s6). The user selects his or her desired circuit pattern (s7), and the server calculates the costs corresponding to this (s8), and provides the calculated costs to the user (s9). Then, the user confirms the costs, and then makes an order (s10).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-41126

(P2002-41126A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	データコード*(参考)
G 0 5 B 19/418		C 0 5 B 19/418	Z 5 B 0 4 9
G 0 3 F 7/20	5 2 1	C 0 3 F 7/20	S 2 1 5 F 0 4 6
G 0 6 F 17/60	1 0 6	C 0 6 F 17/60	1 0 6 5 F 0 5 6
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 0 2 C 5 4 1 R

審査請求 未請求 請求項の数8 O.L (全12頁)

(21)出願番号 特願2000-227324(P2000-227324)

(22)出願日 平成12年7月27日(2000.7.27)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 稲浪 良市

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 馬越 俊幸

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

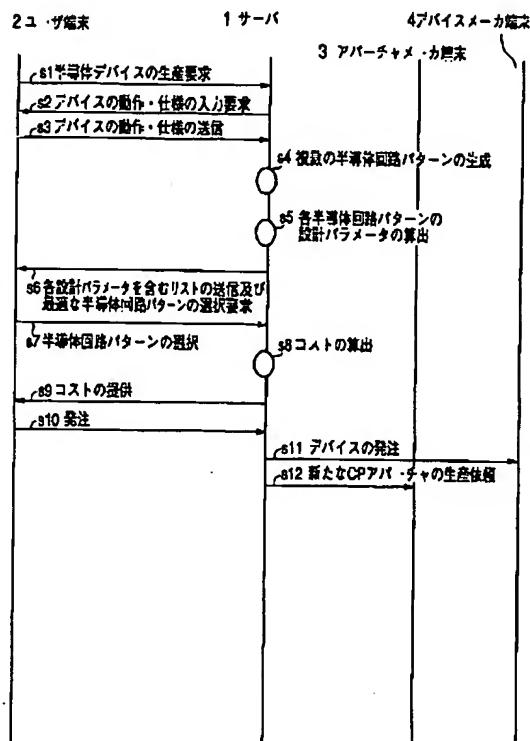
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体デバイスの生産方法及び生産システム

(57)【要約】

【課題】ユーザのニーズを満足する半導体デバイスを効率的に生産する。

【解決手段】ユーザからの要求(s1)に応じて半導体デバイスの仕様の入力をユーザに要求し(s2)、ユーザにより提供された仕様(s3)に基づいてCP方式に基づいた回路パターンを複数生成し(s4)、各回路パターンについて設計パラメータを算出し(s5)、複数の回路パターンの情報を設計パラメータとともにユーザに提供して回路パターンの選択を促す(s6)。ユーザは、希望する回路パターンを選択し(s7)、これに対してサーバはコストを算出し(s8)ユーザに提示する(s9)。ユーザは、コストを確認した後発注を行う(s10)。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 受注希望者と発注希望者との間でネットワークを介して情報を送受信することにより半導体デバイスの生産の受注を行い半導体デバイスを生産する半導体デバイスの生産方法であって、

発注希望者からの要求に応じて半導体デバイスの仕様の入力を発注希望者に促す第1のステップと、

発注希望者により選択された半導体デバイスの仕様に基づいて、キャラクタプロジェクト方式の荷電粒子ビーム露光によりパターンを転写する条件を考慮して、回路パターンを複数生成するとともに、各回路パターンについての少なくとも2つの設計パラメータを算出する第2のステップと、

前記少なくとも2つの設計パラメータを各回路パターンについて発注希望者に提示し、発注希望者が希望する条件を満足する回路パターンの選択を促す第3のステップと、

を有することを特徴とする半導体デバイスの生産方法。

【請求項2】 前記第2のステップでは、各回路パターンについてのコスト及び納品までの期間を算出し、第3のステップでこれらコスト及び納品までの期間を発注希望者に提示することを特徴とする請求項1に記載の半導体デバイスの生産方法。

【請求項3】 前記コストは、前記キャラクタプロジェクト方式の荷電粒子ビーム露光のうち、新たに生産するCPアーチャの生産コストを含めて算出され、前記期間は、新たに生産するCPアーチャの生産期間を含めて算出されることを特徴とする請求項2に記載の半導体デバイスの生産方法。

【請求項4】 前記第3のステップの後、選択された回路パターンの生産をネットワークを介してデバイス生産者に依頼する第4のステップを有することを特徴とする請求項1に記載の半導体デバイスの生産方法。

【請求項5】 前記第3のステップの後、選択された回路パターンの生産に必要なCPアーチャの生産をネットワークを介してCPアーチャ生産者に依頼する第4のステップを有することを特徴とする請求項1に記載の半導体デバイスの生産方法。

【請求項6】 ネットワークを介して半導体デバイスの生産を行う半導体デバイスの生産システムであって、機能単位について単位回路パターンを最適化した複数のスタンダードセルを格納したスタンダードセルライブラリと、

キャラクタプロジェクト方式による荷電粒子ビーム露光に用いられる複数のCPアーチャを設計データとして格納したCPアーチャライブラリと、

ネットワークを介して発注希望者に半導体デバイスの仕様の入力を促す条件設定部と、

前記スタンダードセルライブラリ内のスタンダードセルを用いて前記仕様に基づいて回路パターンを複数生成す

る回路パターン生成部と、

前記回路パターン生成部で取得された複数の回路パターンについての少なくとも2つの設計パラメータを算出するパラメータ算出部と、

ネットワークを介して前記少なくとも2つの設計パラメータを発注希望者に提示し、発注を促す回路パターン選択部とを具備してなることを特徴とする半導体デバイスの生産システム。

【請求項7】 前記パラメータ算出部はさらに、前記複数の回路パターンについてのコスト及び納品までの期間を算出し、

前記回路パターン選択部は、前記発注希望者に前記コスト及び納品までの期間を提示することを特徴とする請求項6に記載の半導体デバイスの生産システム。

【請求項8】 前記コストは、前記キャラクタプロジェクト方式の荷電粒子ビーム露光のうち、新たに生産するCPアーチャの生産コストを含めて算出され、前記期間は、新たに生産するCPアーチャの生産期間を含めて算出されることを特徴とする請求項7に記載の半導体デバイスの生産システム。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、キャラクタプロジェクト(CP)方式を用いた荷電粒子ビーム露光による半導体デバイスの生産方法及び生産システムに関するもの。

## 【0002】

【従来の技術】電子ビーム露光は、半導体回路の微細パターンの加工を行う有効な手段である。

【0003】代表的な電子ビーム露光方式である可変形ビーム(VSB)方式では、回路パターンを微小な長方形や三角形に分割して露光を繰り返す。従って、パターンの露光を行うに際して専用のマスクを作製する必要がない。しかし、電子ビームのショットは莫大な回数が必要となり、スループットの低減は避けられない。

【0004】このVSB方式のスループットを改善すべく、キャラクタプロジェクト(CP)方式が考案されている。このCP方式の場合、ビームサイズ以内の大きさの図形形状の電子ビームを成形して、図形(キャラクタ)の一括露光を行う。これによれば、ショット数を削減し、スループットが向上する。電子ビームの成形は、キャラクタ形状の開口を持つCPアーチャによってなされる。通常の電子ビーム露光装置では、キャラクタ選択偏向器の偏光領域内に配置することができる開口の数は、多くとも100個程度である。従って、メモリのような繰り返し使用されているパターンが多いデバイスでは、パターン中の多くのCP方式で露光できる。しかし、ASIC等のロジックデバイスの場合、繰り返し使用される図形の種類が数百～数千種類と多くなっている。従って、CP方式で露光するよりも、VSB方式で

露光する割合が多くなる。VSB方式の割合が多くなれば、CP方式を適用することにより得られるショット回数の削減効果は当然少なくなる。従って、高いスループットが得られない。それどころか、製品ごとにCPアーチャを作製する必要があるため、製作コスト及び期間を削減することができないという問題が生じる。

【0005】このようなロジックデバイス、特にスタンダードセル(SC)に基づいて設計される回路パターンの生成で、CP方式の電子ビーム露光を行うときのキャラクタとなるSCの数を大幅に削減したり、使用するSCを限定して、論理合成及び自動配置配線(P&R: Place And Route)を行う方法が提案されている。この方法によれば、所望の回路パターンの性能やチップ面積等は若干劣る。しかし、電子ビーム露光のショット数は少なくできる。また、CP露光を行うキャラクタ数を、露光装置で用意できる数以下にすることも可能である。複数の異なるロジックデバイスに対して同じCPアーチャを使用することも可能となる。従って、製品ごとにマスク、すなわちCPアーチャを作製する必要が無くなり、製作コスト及び期間を省略することができる。

【0006】さらに、上記設計方法では、所望のデバイス仕様に対して複数のパターンが生成される。従って、それら複数のパターンの中からコスト面、納期の面、機能の面より最も好ましいと思われるパターンを選択することができる。この場合、パターンの選択の判断材料としては、1) 電子ビームのショット数が最も少なくなること、すなわち露光のスループットが最大となること、2) 既に作製してあるCPアーチャを用いて電子ビーム露光を行うこと、すなわちCPアーチャ作製のコスト及び期間を省略すること、3) 製作するデバイスのチップ面積が最小になること、4) 製作するデバイスの消費電力が最小となること、5) 製作するデバイスの動作周波数が最速となること、等が挙げられる。そして、これらの条件の中から、どの条件を優先し、その結果どの回路パターンのロジックデバイスを製作するのかはデバイス製作を依頼する本人、すなわち半導体製品メーカーからみればユーザ、顧客が行うのが好ましい。

【0007】従来の半導体デバイスの回路パターンの設計から電子ビーム露光までの流れを図10のフローチャートを用いて説明する。

【0008】図10に示すように、まず半導体デバイスの電子回路の記述を行う(s101)。通常、ハードウェア記述言語(HDL)を用いて記述する。特に、レジスタ及びレジスタ間の論理回路の構成及び動作を記述するレジスタトランസファレベル(RTL)記述が用いられる。

【0009】次に、記述したRTL等と、動作周波数等のデバイス特性やチップ面積等の設計制約条件に基づいて論理合成を行う(s102)。これにより、設計制約条件を満たす論理回路ができる。そして、その論理回路

に基づいて回路パターンが合成される。ここで、論理ゲートやフリップフロップ等の機能単位について単位回路パターンを最適化したスタンダードセルに機能を割り当てる。そして、チップ上にそれらスタンダードセルのパターンを配置し、各スタンダードセル間を配線する。この配置配線はP&R(Place And Route)と呼ばれる。

【0010】次に、様々な検証を行い、デバイスのパターンデータを生成する(s103)。

【0011】以上、(s101)乃至(s103)は回路パターンの設計者によりなされる。

【0012】そして、以下の(s104)以降のステップはプロセス技術者により行われる。

【0013】まず、パターンデータを回路パターンの設計者から受け取り(s104)、パターンデータに含まれる図形中から、CP露光を行う際のキャラクタとなり得る図形、例えば繰り返し使用される図形を抽出する。そして、その抽出された図形から、露光装置に搭載可能なキャラクタ数を限界として、CP露光を行うキャラクタに割り当てる(s105)。それ以外の図形は、VSB方式で露光することを決定する。

【0014】次に、割り当てられたキャラクタについてのCPアーチャを製作する(s106)。そして、(s104)及び(s105)の情報に基づいて、設計情報をパターンデータを使用する電子ビーム露光装置に入力可能な露光データに変換する(s107)。次に、(s106)で作製されたCPアーチャを露光装置に装着し、(s107)で生成された露光データを露光装置に入力し、電子ビーム露光を実施する(s108)。そして、電子ビーム露光が完了した試料を露光装置から取り出し、加熱や現像を経てレジストパターンが作製される(s109)。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】以上のような回路パターンの設計及び電子ビーム露光の手法の場合、(s101)～(s103)までは、回路パターンの設計者、(s104)～(s109)はプロセス技術者が行うというように、各工程を担当する者が单一ではなく複数となる。この場合、例えば設計者が設計する回路パターンについては、CP方式での電子ビーム露光でのキャラクタについては考慮されていない。一方、プロセス技術者は、設計者が生成したパターンデータ中から、CP露光を行う単位となる図形を抽出してキャラクタに割り当っていく。しかし、プロセス上制約を受ける内容について設計者はすべて考慮することはできない。従って、プロセス上ある設計上のパラメータについては満足しているが、他のパラメータについては非常に効率の悪い露光方法をとらざるを得ない場合が少くない。また、このことが、半導体デバイスの生産に当たり、ユーザのニーズには必ずしも合致しない設計及び露光方法をとることに結びつく。すなわち、ユーザが希望する半導体デバイス

の動作を半導体デバイスマーカに指示すると、その動作に基づいて最高の設計条件を満たす回路パターンを設計者が選択し、その選択された回路パターンをプロセス技術者が電子ビーム露光により製作するというプロセスがとられているため、最終的に製作されるまでのコストや期間等がユーザのニーズに対応できないという問題があった。すなわち、ユーザにとっては上記1)～5)に示すようなパターン選択の判断材料があるにもかかわらず、実質的にはユーザにとってのパターン選択の判断は極めて限られた設計上のパラメータのみに基づいてなされていた。

【0016】本発明は上記課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、ユーザのニーズを満足する半導体デバイスを効率的に生産する半導体デバイスの生産方法及び生産システムを提供することにある。

#### 【0017】

【課題を解決するための手段】この発明の第1の観点によれば、受注希望者と発注希望者との間でネットワークを介して情報を送受信することにより半導体デバイスの生産の受注を行い半導体デバイスを生産する半導体デバイスの生産方法であって、発注希望者からの要求に応じて半導体デバイスの仕様の入力を発注希望者に促す第1のステップと、発注希望者により選択された半導体デバイスの仕様に基づいて、キャラクタプロジェクト方式の荷電粒子ビーム露光によりパターンを転写する条件を考慮して、回路パターンを複数生成するとともに、各回路パターンについての少なくとも2つの設計パラメータを算出する第2のステップと、前記少なくとも2つの設計パラメータを各回路パターンについて発注希望者に提示し、発注希望者が希望する条件を満足する回路パターンの選択を促す第3のステップと、を有することを特徴とする半導体デバイスの生産方法が提供される。

【0018】ここで、半導体デバイスの仕様とは、論理合成やP&Rを行っていない段階の半導体デバイスの受注希望者が受注するに当たり半導体デバイスを特定するための受注条件を指し、例えば動作周波数、チップ面積、消費電力等の設計パラメータも含まれる。

【0019】ここで、設計パラメータとは、例えば動作周波数、チップ面積、消費電力、スループット、ショット数、CPアーチャの使用数等の半導体デバイスの設計に必要なパラメータのみならず、半導体デバイスの受注から発注までに受注希望者がデバイスの受注条件として参照される例えば製作コスト、納品までの期間等のパラメータも含むものとする。換言すれば、設計パラメータは、受注者が受注するか否かを決定するのに影響を及ぼすすべてのパラメータを指す。

【0020】このような構成によれば、半導体デバイスの生産を依頼する発注希望者は、ネットワークを介して受注希望者と直接接続し、生産したいデバイスの回路パ

ターンの生成をシミュレーションにより行うことができる。その際、発注希望者が必要とするデバイスの性能、チップ面積やコスト、期間等、発注希望者が生産を依頼する際の判断材料となる各パラメータをそれぞれ発注希望者に提示し、発注希望者に選択させることにより、従来設計者、プロセス技術者及び発注希望者間で生じていたデバイス設計の意識のズレを生じることなく発注希望者にとって最適なパターンの選択及び発注を実現することができる。より具体的には、デバイスの性能が若干劣るかわりに、安くあるいは早く生産できるパターンを選択することができる。

【0021】また、電子ビーム露光の際に使用するCPアーチャに既存のものを使用するか否かにより変動するデバイスの製作期間を正確に見積もることができる。既存のものを使用する点を考慮するため、CPアーチャを製作するコストと期間を省略でき、少量生産を行った場合でもコストの上昇を抑制できる。

【0022】また、受注希望者から半導体メーカーとCPアーチャメーカーにリアルタイムで発注できるため、製作期間の短縮が図れる。

【0023】望ましくは、第2のステップでは、各回路パターンについてのコスト及び納品までの期間を算出し、第3のステップでこれらコスト及び納品までの期間を発注希望者に提示する。これにより、半導体デバイスの設計パラメータのみならず、より発注希望者のニーズに近いパラメータをパターン決定の判断基準とすることができる、より高い顧客満足度を得ることができる。

【0024】望ましくは、コストは、前記キャラクタプロジェクト方式の荷電粒子ビーム露光のうち、新たに生産するCPアーチャの生産コストを含めて算出され、前記期間は、新たに生産するCPアーチャの生産期間を含めて算出される。これにより、キャラクタプロジェクト方式を用いた荷電粒子ビーム露光を行う場合に、既存のCPアーチャと新たに生産する必要のあるCPアーチャとの間で生じる生産期間及び生産コストまでを含めて発注希望者にパターン選択の判断基準として提供される。従って、発注希望者は受注希望者の状況をより的確に把握してパターンの選択を行うことができる。また、マスクを製作するコストと期間を省略することができるため、少量の生産を行った場合にもコストの上昇を抑制することができ、発注希望者それぞれのニーズに合った半導体デバイスの生産が可能となる。

【0025】望ましくは、第3のステップの後、選択された回路パターンの生産をネットワークを介してデバイス生産者に依頼する第4のステップを有する。また、第3のステップの後、選択された回路パターンの生産に必要なCPアーチャの生産をネットワークを介してCPアーチャ生産者に依頼する第4のステップを有する。これにより、受注希望者から直接工場等のデバイスマーカやCP生産者に半導体デバイスの生産依頼を受注と同

時に行うことができる。これにより、ユーザの希望を反映した半導体デバイスを迅速に生産することができる。【0026】なお、方法に係る本発明はその方法を実現するための半導体デバイスの生産システムとしても成立する。

## 【0027】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。

【0028】(第1実施形態) 図1は本発明の第1実施形態に係る半導体デバイス生産システムのネットワーク構成を示す図である。受注希望者としてこの生産システムを運営するシステム運営者のサーバ1、この生産システムを利用する複数の発注希望者としてのユーザのユーザ端末2、サーバ1からのアパートチャ生産発注に基づきアパートチャを生産するアパートチャメーカーのアパートチャメーカー端末3、サーバ1からのデバイス生産発注に基づきデバイスを生産するデバイスマーカーのデバイスマーカ端末4がネットワーク5に接続されている。ネットワークの接続様は有線でも無線でもよい。また、デバイスマーカやアパートチャメーカーの工場に配置された露光装置を制御する露光制御コンピュータにサーバ1がネットワーク5を介さずに専用線等で直接接続されていてもよい。

【0029】図2はサーバ1の詳細な構成の一例を示す図である。図2に示すように、ネットワーク5との間のデータのやりとりを行なうインターフェース11が各種データ処理を行うプロセッサ12に接続されている。プロセッサ12はセルライブラリ13及びCPアパートチャライブラリ14に接続されている。CPアパートチャライブラリ14は、デバイスマーカやアパートチャメーカーの工場に配置された露光制御コンピュータに専用線等で直接接続されていてもよい。

【0030】プロセッサ12は、条件設定部12a、回路パターン生成部12b及び回路パターン選択部12cを有する。条件設定部12aはユーザに半導体デバイスの動作・仕様の入力あるいは選択を促し、回路パターン生成の基本となる条件の設定を行う。回路パターン生成部12bはユーザから提供された動作・仕様に基づいて複数の回路パターンを生成する。また、各回路パターンの設計パラメータを算出する。パターン選択部12cは、回路パターン生成部12bで得られた複数の回路パターンを設計パラメータとともにユーザに提示し、ユーザに回路パターンの選択を促す。

【0031】セルライブラリ13は、機能単位について単位回路パターンを最適化した複数のスタンダードセルを格納しており、このスタンダードセルを組み合わせることにより回路パターンが生成される。

【0032】CPアパートチャライブラリ14は、キャラクタプロジェクト方式による電子ビーム露光に用いられる複数のCPアパートチャを設計データとして格納しており、このCPアパートチャライブラリ14内のCPア

パートチャを用いることにより、VSB方式とCP方式を組み合わせた回路パターンの設計が可能となる。

【0033】次に、図3に示すタイミングチャート及び図4に示すフローチャートを用いて本実施形態に係る半導体デバイス生産システムの動作を説明する。なお、以下に示す動作におけるデータのやりとりは、特に示さない限りネットワーク5を介して行われるものとする。

【0034】まず、ユーザがユーザ端末2からサーバ1に接続し、サーバ1に半導体デバイスの生産要求を行う(s1)。プロセッサ12内の条件設定部12aは、例えば図5に示すようなデバイス動作・仕様選択画面をユーザ端末2に提供する(s2)。図5に示すように、41には代表的なデバイスのリストが表示され、42~44はそれぞれ動作周波数、チップ面積、生産数を入力できる。生産数は、チップ数、ウェハ数、ロット数等で指定可能である。なお、これら動作周波数やチップ面積等、ユーザが希望するデバイスを特定する設計しようとしての各パラメータは、例えば動作周波数であれば600MHz~620MHzや600MHz以上というよう一義に定まる値ではなく所定の範囲を有する値として入力されるのが好ましい。ユーザが予めハードウェア記述言語(HDL)によりデバイスの動作を記述して用意しておいた場合、図5の41に設けられた“Upload”ボタンをクリックし、サーバ1に提供することもできる。“OK”ボタンをクリックするとこれら入力データがサーバ1に送信され(s3)、次のステップ(s4)に進むことができる。また、“Cancel”ボタンをクリックするとサーバ1との接続を終了することができる。

【0035】サーバ1内の回路パターン生成部12bは、ユーザ端末2から送信された動作周波数、チップ面積、生産数等の設計仕様に基づいて半導体回路パターンの合成を行う(s4)。

【0036】図6は回路パターン生成部12bにおける半導体回路パターンの合成動作(s4)のフローチャートを示す図である。

【0037】まず、回路パターンがCP方式の電子ビーム露光で形成されると仮定し、CPアパートチャライブラリ14に登録されているCPアパートチャ上に配置されているスタンダードセルのみを用いてパターンの合成を試みる(s41)。ここで、CPアパートチャライブラリ14に登録されているCPアパートチャは、実際の電子ビーム露光装置に装着可能なCPアパートチャに対応しているもので、CPアパートチャ内に用意されているスタンダードセルの情報を取得することができる。換言すれば、新たなCPアパートチャの作製が必要となるスタンダードセルは使用しないものと仮定してパターンを合成する。

【0038】CPアパートチャライブラリ14に登録されているCPアパートチャが複数ある場合には、その組み合せの数だけ上記(s41)における合成を繰り返し、

各組み合わせについてパターンを合成する。従って、すべての組み合わせについてパターンを合成したか否かを判定し(s42)、すべてについて合成が終了した場合には(s43)に進み、終了していない場合には他の組み合わせについて再度(s41)の工程に進む。

【0039】(s43)では、通常の方法を用いて、スタンダードセルライブラリ13内のすべてのスタンダードセルを使用可能の状態で論理合成及びP&Rを行い、パターンを生成する。ここで、CPアーチャを用いない部分の露光についてはVSB方式が割り当てられる。

【0040】次に、(s44)では、(s43)で生成したパターンをCP方式の電子ビーム露光を行う場合のショット回数を計算する。次いで、(s45)では、得られた回路パターンが登録済みCPアーチャに適用可能か否かを判定し、適用できない回路パターンを新たなCPアーチャに割り当てる。そして、新たなCPアーチャの製作に必要なコスト及び期間を算出する。次いで、パターンの中で使用されているスタンダードセルのうち、CP方式で露光することにより、VSB方式で露光した場合に比較して最もショット回数の削減効果が小さいスタンダードセルを次回以降のパターンの合成では使用しないと定義する(s46)。

【0041】以上に示したパターンの合成、ショット回数の計算及び次回以降使用しないスタンダードセルの決定を、ユーザが指定した動作周波数等の設計仕様を満足するパターンが合成できなくなるまで繰り返し行い、その都度パターンを生成する。すなわち、ユーザによる設計仕様の各パラメータを満足しているか否かをパターンの生成する毎に判定し(s47)、満足している場合には(s43)に戻り別の合成パターンについてのショット回数を計算する。満足しなくなった場合には回路パターンの合成を終了する(s48)。なお、(s47)では、判定の際にユーザにより指定された各パラメータを各合成パターン毎に算出しておき、その各パラメータを保存しておく。

【0042】以上の合成動作により、合成された半導体回路パターンが複数得られる。そして、各パターンについての動作周波数、チップ面積、消費電力、マスク作製の有無、コスト及び製作期間等の設計パラメータを算出(s5)し、次いで回路パターン選択部12cは各パターンについてこれら設計パラメータを例えば図7に示す画面例のように一覧としてユーザ端末2の画面上に表示する(s6)。なお、マスク作製コスト及び製作期間の算出には、(s45)で算出したCPアーチャの製作コスト及び期間が考慮される。

【0043】スタンダードセル数を削減していく場合の消費電力、ショット回数、チップ面積の各設計パラメータ値の算出例を図8に示す。横軸はスタンダードセル数、縦軸は使用するスタンダードセルの制限無く生成したパターンを基準に規格化した面積、消費電力、ショッ

ト回数である。図8は、100MHzの周波数で動作することを条件としてパターンを合成したもので、CP方式の電子ビーム露光装置で使用できるキャラクタ数は100個である。即ち、CPアーチャ上に、キャラクタ100個分のスタンダードセルの形状を用意することができ、その個数を超える分はVSB方式で露光する。

【0044】また、図8は、通常の方法で設計した場合に使用したスタンダードセルは84個で、徐々に回路の合成に使用するスタンダードセルの数を減らしながら生成した場合である。図中の(A)～(F)は、それぞれ、(A)通常の設計方法によるパターン、(B)消費電力が最も少ないパターン、(C)チップ面積が最も小さいパターン、(D)電子ビームのショット数が充分少なく、チップ面積、消費電力の増加も許容できる範囲のパターン、(E)電子ビームのショット回数が最も少なくなるパターン、(F)スタンダードセルの数が充分少なく、既に登録済み(所有している)のCPアーチャ上に用意されているスタンダードセルのみで合成できるパターン、である。また、このような各パラメータから、サーバ1内の回路パターン生成部12bは、各パターンの電子ビームのショット数に基づき電子ビーム露光のスループットを計算する。そして、得られたスループットと、CPアーチャの作製の有無、製作する半導体デバイスのロット数あるいはウェハ枚数から、製作にかかるコストと期間を算出する。

【0045】例えば、(F)のパターンを選択し、既存の、すなわち登録済みのCPアーチャを使用して電子ビーム露光を行う場合、半導体デバイスのチップ面積は通常の場合の(A)のパターンと比較して6%、消費電力は15%程度増加するため、デバイスの性能は劣る。一方、電子ビームのショット数はほぼ半減でき、さらに新規にCPアーチャを作製する必要がないため、CPアーチャ作製にかかるコストと期間を削減することができ、これらのパターンの中では最も安く、最も速くデバイスの製作を行うことができる。

【0046】ユーザは、これら複数の設計パラメータを判断材料として、一覧として表示された各パターンのリストから希望する半導体回路パターンがあるか否かを判定し(s6a)、あると判定した場合にはその希望するパターンを、そのパターンに対応して設けられた画面上のチェックボックスをクリックすることにより選択する。パターンを選択した後、“OK”ボタンをクリックすることにより、パターンの選択情報がサーバ1に送信される(s7)。パターンの選択情報を受信したサーバ1は、そのパターンによりデバイス製作の発注を行っため、その選択されたパターンの最終的なコストを算出し(s8)、そのコストに関するデータをユーザ端末2に送信してユーザ端末2の画面に例えば図9のように表示するとともに、ユーザに支払い方法の入力を促す(s9)。図9に示す画面で提示されたコストでユーザが満

足する場合、支払い方法を入力した後、“OK”ボタンをクリックする。この“OK”ボタンのクリックによりサーバ1に正式な発注がなされる(s10)。サーバ1は、正式な発注をユーザから受けた後、デバイスマーカ端末4にデバイスの発注を行うとともに、ユーザにより選択されたパターンに関する情報が送信される(s11)。また、必要であれば新たなCPアーチャの生産依頼をアーチャメーカー端末3に行う(s12)。以上により半導体デバイスの受注及び発注動作が終了する(s13)。

【0047】デバイスマーカ端末4は、使用するCPアーチャのデータをサーバ1のCPアーチャライブラリ14から取得する。そして、このデータを基にデバイスマーカは、そのデータに対応したCPアーチャを露光装置に装着してパターン露光を開始する。新たなCPアーチャの生産依頼があった場合、デバイスマーカは、アーチチャメーカーからネットワーク5を介さずに納入されたCPアーチャを露光装置に装着し、パターンの露光を開始する。

【0048】ステップ(s6a)で、ユーザが満足できるパターンが無かった場合には、ステップ(s14)に進み、デバイスの動作周波数やチップ面積等の設計仕様を変更して設計をやり直すかどうかを判断する。設計をやり直す場合には図7に示す画面上で“Retry”ボタンをクリックしてステップ(s2)の図5に示す画面における条件(設計仕様)の再入力に戻る。設計を終了する場合には“Cancel”ボタンをクリックしてサーバ1への接続を終了する(s13)。

【0049】このように本実施形態によれば、半導体デバイスの生産を依頼するユーザは、ネットワーク5を介して半導体メーカーのサーバと直接接続し、生産したいデバイスの回路パターンの生成をシミュレーションにより行なうことができる。その際、ユーザが必要とするデバイスの性能、チップ面積やコスト、期間等、ユーザが生産を依頼する際の判断材料となる各設計パラメータをそれぞれユーザに提示し、ユーザに選択させることにより、従来設計者、プロセス技術者及びユーザ間で生じていたデバイス設計の意識のずれを生じることなくユーザにとって最適なパターンの選択及び発注を実現することができる。より具体的には、デバイスの性能が若干劣るかわりに、安くあるいは速く生産できるパターンを選択することができる。

【0050】また、電子ビーム露光の際に使用するCPアーチャに既存のものを使用するか否かにより変動するデバイスの製作期間を正確に見積もることができる。既存のものを使用する点を考慮するため、CPアーチャを製作するコストと期間を省略でき、少量生産を行った場合でもコストの上昇を抑制できる。

【0051】また、サーバから半導体メーカーやCPアーチチャメーカーにリアルタイムで発注できるため、製作期

間の短縮が図れる。

【0052】本発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、サーバ1、ユーザ携帯端末2のみネットワーク5に接続されれば、アーチチャメーカー端末3、デバイスマーカ端末4はネットワーク5に接続されていても良い。この場合、デバイスマーカ端末4は少なくともサーバ1のCPアーチチャライブラリ14に専用線等により接続され、データを受信できるのが好ましい。

【0053】また、サーバ1はデバイスマーカを兼ねていてもよい。すなわち、サーバ1がユーザから発注を受け、デバイスマーカとしてそのユーザからの発注情報に基づいてパターン製作を行ってもよい。

【0054】また、ユーザに複数の回路パターンから希望するパターンを選択する場合に図7に示すような各パラメータの一覧をリストとして表示する場合を示したが、例えば図8に示すように各パラメータを通常の設計方法で規格化した折れ線グラフで示してもよい。もちろん、この他各設計パラメータがユーザに提供される形態をとれば、棒グラフ等如何なる方法でユーザに各設計パラメータが示されても良い。また、図7では動作周波数等の各設計パラメータはユーザが実際に半導体デバイスの機能等を判定する単位を用いて提示したが、例えば図8に示すような規格化した値を併せて提示してもよいし、規格化した値のみを提示してもよい。この場合、ユーザが(s3)で提供したデバイスの動作・仕様の各設計仕様値を1として規格化するのが好ましい。

【0055】また、電子ビーム露光により半導体デバイスを生産するものとして示したが、イオンビーム等、他の荷電粒子ビーム露光も含まれることはもちろんである。

【0056】また、CP方式にVSB方式を組み合わせた例として示したが、VSB方式でなくてもよい。例えば、ポイント・ビーム等によるいわゆる一筆書き方式とCP方式を組み合わせてもよい。

【0057】さらに、本発明における発注希望者(ユーザ)と受注希望者(サーバ)の間での情報のやりとりは、必ずしもネットワークを介さずに行ってもよい。例えば、サーバ側で複数の回路パターンについてのユーザの必要とする設計パラメータを算出し、その設計パラメータを一覧として表示したリストを紙面等でユーザに提示し、ユーザに希望する回路パターンの選択を促してもよい。従って、この明細書には以下の発明が含まれることを確認する。

【0058】受注希望者と発注希望者との間で情報をやりとりすることにより半導体デバイスの生産の受注を行い半導体デバイスを生産する半導体デバイスの生産方法であって、発注希望者からの要求に応じて半導体デバイスの仕様の提供を発注希望者に促す第1のステップと、発注希望者により選択された半導体デバイスの仕様に基

づいて、キャラクタプロジェクション方式の電子ビーム露光によりパターンを転写する条件を考慮して、回路パターンを複数生成するとともに、各回路パターンについての少なくとも2つの設計パラメータを算出する第2のステップと、前記設計パラメータを各回路パターンについて発注希望者に提示し、発注希望者が希望する条件を満足する回路パターンの選択を促す第3のステップと、を有することを特徴とする半導体デバイスの生産方法。

## 【0059】

【発明の効果】以上詳述したように本発明の半導体デバイスの生産方法によれば、ユーザのニーズを満足する半導体デバイスを効率的に生産することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係る半導体デバイス生産システムのネットワーク構成を示す図。

【図2】同実施形態に係るサーバの詳細な構成の一例を示す図。

【図3】同実施形態に係る半導体デバイス生産システムの動作のタイミングチャートを示す図。

【図4】同実施形態に係る半導体デバイス生産システムの動作のフローチャートを示す図。

【図5】同実施形態に係るユーザ端末側に表示されるデバイス動作・仕様選択画面の一例を示す図。

## 【図6】同実施形態に係るサーバにおける半導体回路パ

ターンの合成動作のフローチャートを示す図。

【図7】同実施形態に係るユーザ端末側に表示されるパターン選択画面の一例を示す図。

【図8】同実施形態に係るスタンダードセル数を削減していった場合のスタンダードセル数に対する消費電力、ショット回数及びチップ面積の各パラメータの算出例を示す図。

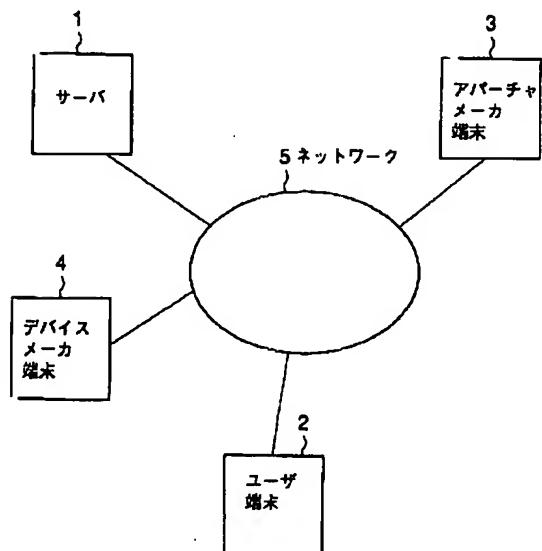
【図9】同実施形態に係るユーザ端末側に表示される発注画面を示す図。

【図10】従来の半導体デバイスの生産のフローチャートを示す図。

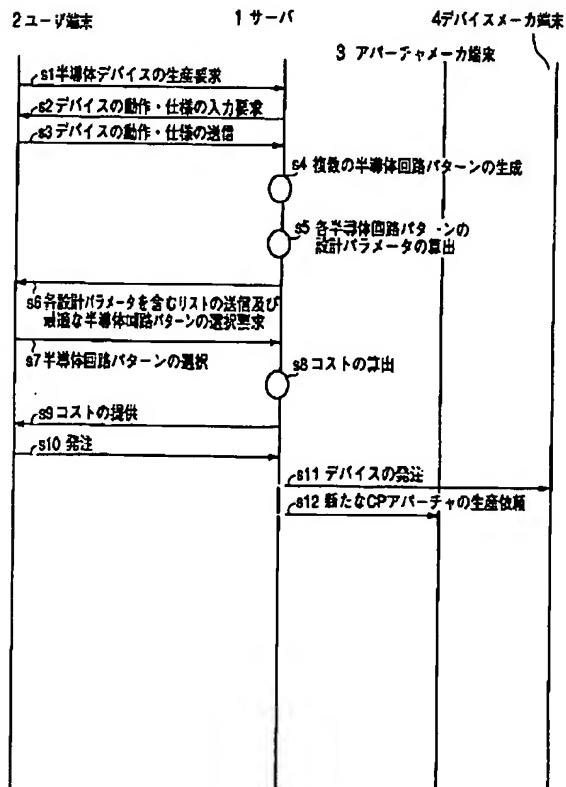
## 【符号の説明】

- 1…サーバ
- 2…ユーザ端末
- 3…アバーチャメーカー端末
- 4…デバイスマーカ端末
- 5…ネットワーク
- 1 1…インタフェース
- 1 2…プロセッサ
- 1 2 a…条件設定部
- 1 2 b…回路パターン生成部
- 1 2 c…回路パターン選択部
- 1 3…セルライブラリ
- 1 4…CPアバーチャライブラリ

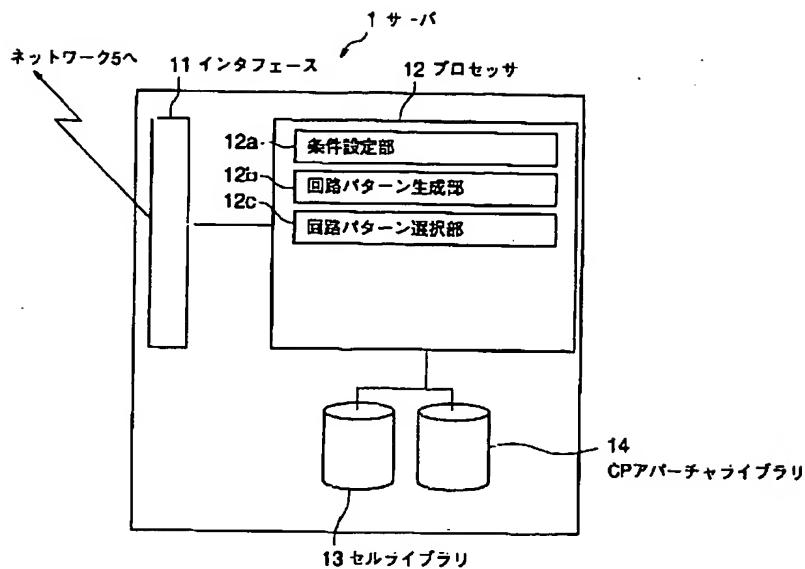
【図1】



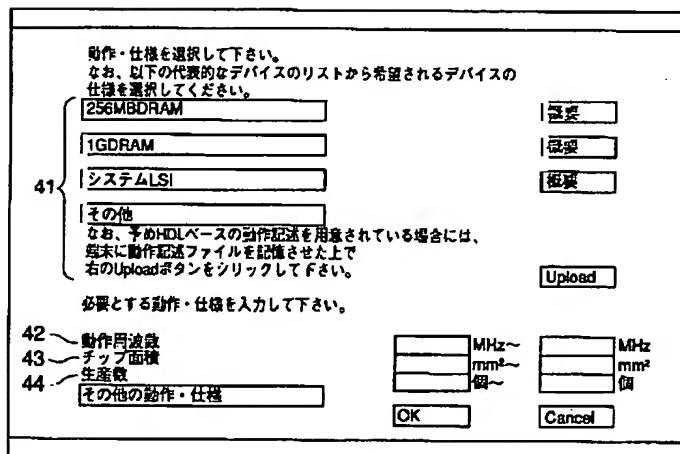
【図3】



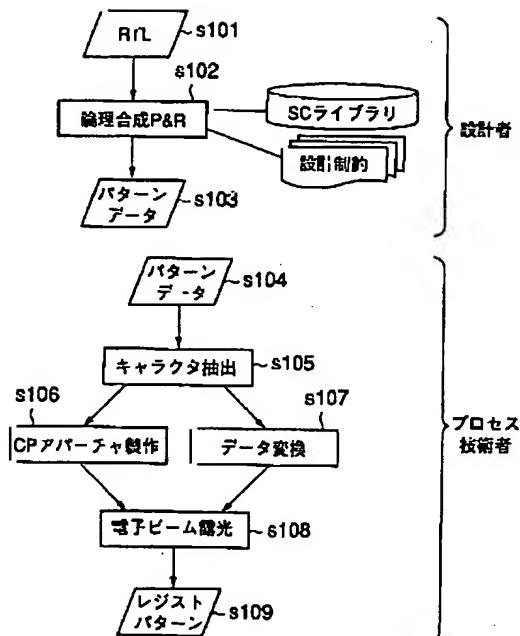
【図2】



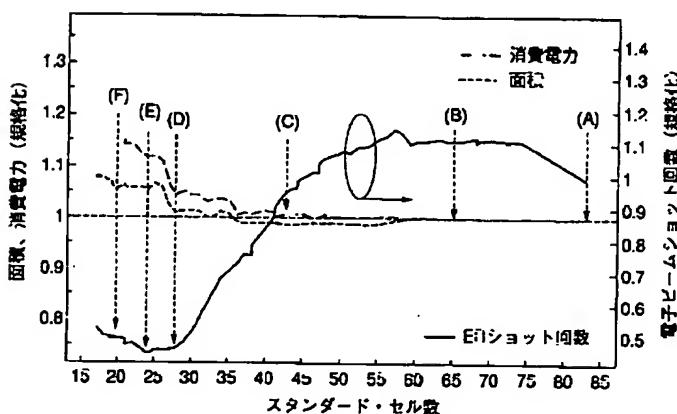
【図5】



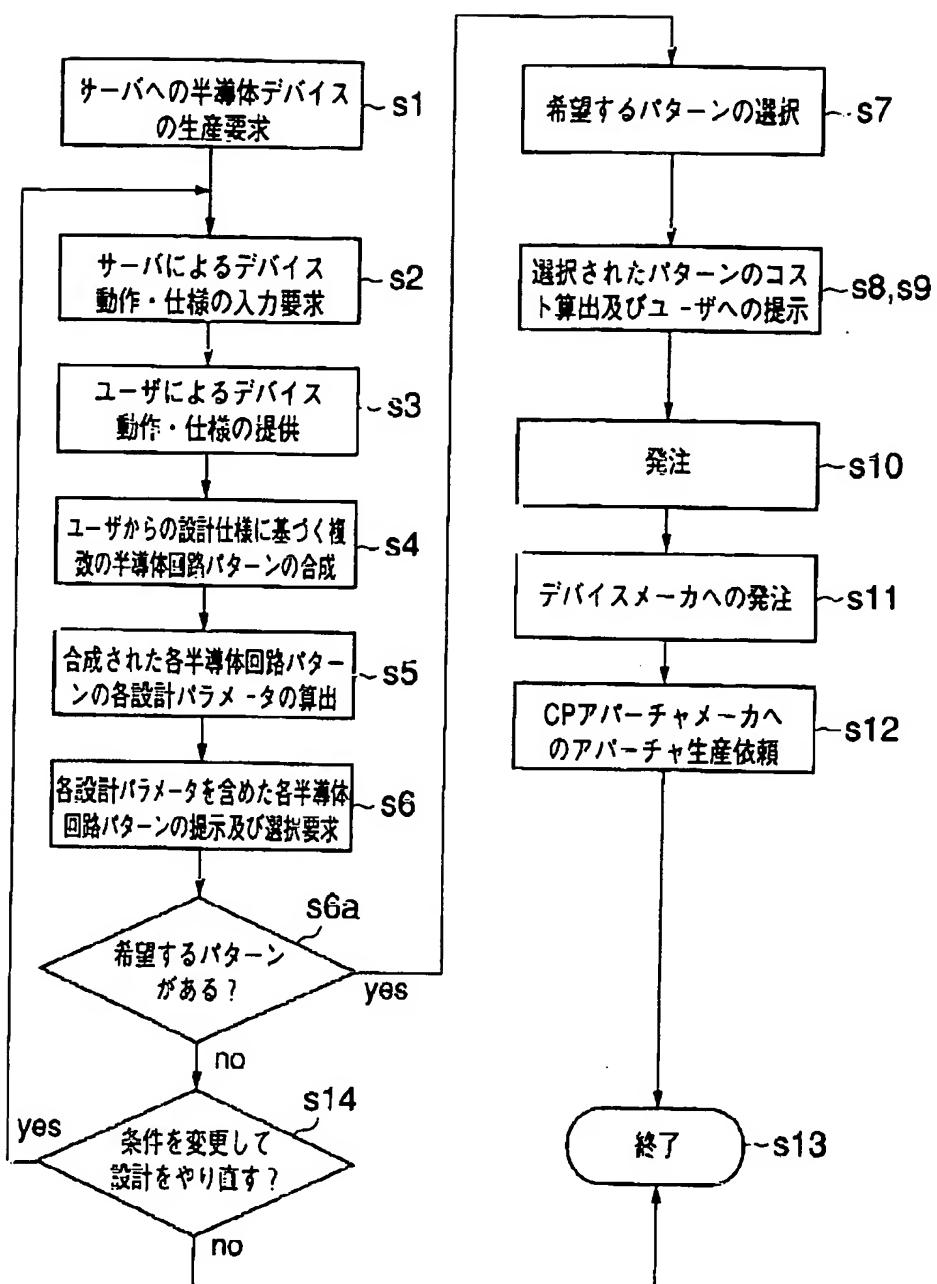
【図10】



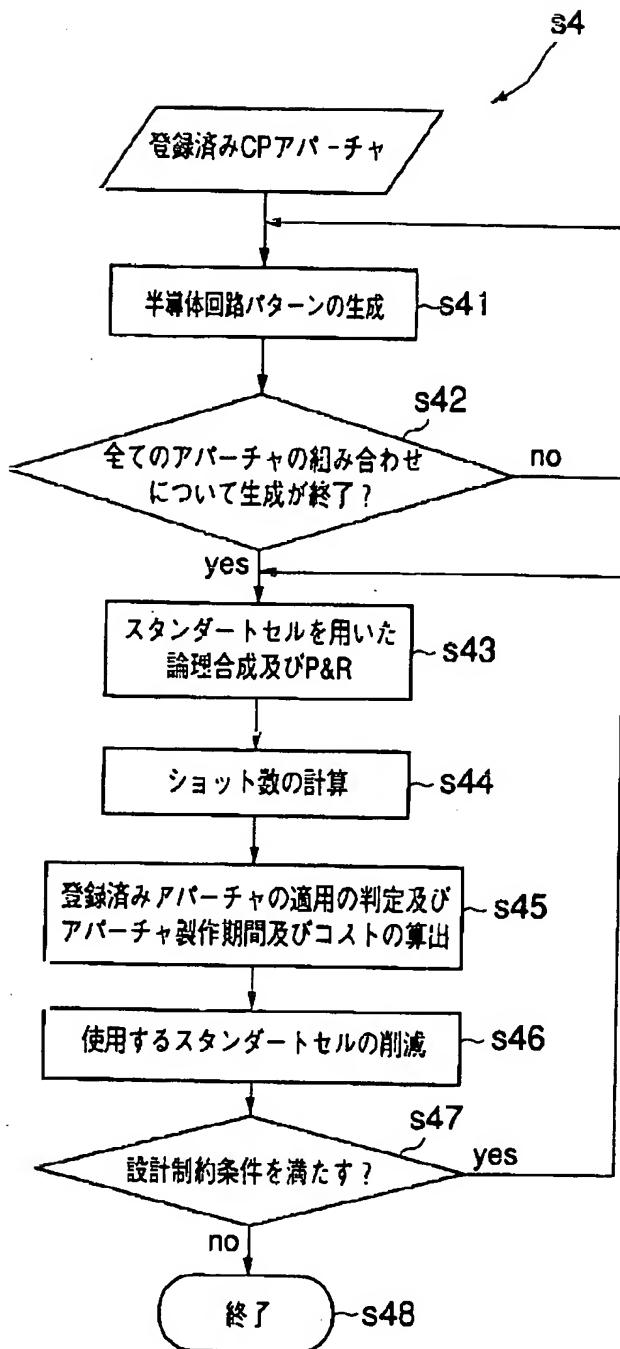
【図8】



【図4】



【図6】



【図7】

以下の中から希望されるデバイスについて左のチェックボックスをクリックし、  
送信されましたらOKをクリックし、希望されるものが無い場合はRetryあるいはCancel  
をクリックしてください。(Retryにより動作・仕様の設定から開始できます)

パートン番号	周波数	周波数帯	消費電力	マスク作成	コスト	期間
1	632MHz	32K63MHz	15mW	3枚	¥1,200,000	85日
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【図9】

希望されるデバイスの御見扱は以下のようになっております。  
金額をご確認の上、発注される場合には支払い方法を入力した上で、  
OKボタンをクリックしてください。発注されない場合にはCancelボタンを  
クリックしてください。

見積もり  
〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円  
御支払方法

---

フロントページの続き

(72)発明者 奥村 勝弥  
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株  
式会社東芝マイクロエレクトロニクスセン  
ター内

Fターム(参考) 5B049 BB07 CC05 CC21 DD01 DD05  
EE01 FF03 FF04 GG04 GG07  
5F046 AA28  
5F056 AA06 AA40